УДК 538.971 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АДСОРБЦИИ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА НА ОКСИДНОМ ПОЛУПРОВОДНИКЕ

Раскалиев Арлен Нурланулы

970624300955@enu.kz

Магистрант 2–го курса кафедры «Ядерная физика, новые материалы и технологии», Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан Научный руководитель – А.Усеинов

Разработка датчиков легких газов с высоким диапазоном чувствительности и расширенной функциональностью большой интерес. продолжает вызывать Bce экспериментальные результаты показывают, газовые латчики на основе наноструктурированного оксида цинка (ZnO) (наностержни/нанопроволоки), благодаря своей большой площади поверхности, обладают потенциалом для высокочувствительного и селективного обнаружения широкого спектра различных молекул газа и биомолекул в режиме реального времени.[1-3].

Целью нашей работы является компьютерное моделирование с применением методов вычислительной химии и физики процесса адсорбции/десорбции молекулы углекислого газа на поверхности ZnO на поверхности. Между тем, важной задачей является определение электронной структуры системы «адсорбент-поверхноть», влияния собственных дефектов на сорбцию и возможности образования новых молекулярных комплексов. Вычисления выполненыв программе CRYSTAL.

Атомная структура ZnO показана на рис. 1. Для моделирования адсорбции диоксида углерода на поверхности ZnO была смоделирована периодическая модель атомной пленки с индексами сечения ($10\overline{0}$) конечной толщины вдоль оси z (5 слоев) и протяженной вдоль осей x и y. Интегрирование обратного пространства в модели атомной плиты было выполнено с помощью сетки Пак-Монкхорста $4 \times 4 \times 1$ [4].



Рисунок 1 - Схематическое представление структуры вюрцита ZnO (слева), и позиции, на которых может абсорбироваться междоузельный водород (справа). ВС указывает на положения в центре химических связей, а AB обозначают места вне связи, параллельно или перпендикулярно ей

Для подтверждения достоверности использованного метода расчета мы провели расчеты параметров решетки (a, c, u), запрещенной зоны (E_g) и объемного модуля (B) объемного образца ZnO со структурой вюрцита, которые приведены в таблице 1 вместе с аналогичными расчетными и экспериментальными данными.

	PBE0	GGA [5]	LDA+U [6]	Эксп. [7]	
<i>a</i> , Å	3.274	3.28	3.148	3.249	
<i>c</i> , Å	5.267	5.29	5.07	5.187	
U	0.382	-	0.379	0.381	
<i>Е</i> g ,эВ	3.57	0.74	1.51	3.43	
<i>В</i> , ГПа	153	-	-	143[8]	

Таблица-1 - Рассчитанные параметры решетки (a, c, u), рассчитанная запрещенная зона (E_g) , рассчитанный модуль упругости (B).

Мы рассмотрели несколько геометрических конфигураций адсорбированной молекулы CO₂(рис. 2 a, b, c, d, e, f). Концентрация адсорбата составляла 1/12 (8 ат.%). Концентрацию примеси CO₂ рассчитывали как отношение числа молекул к общему числу атомов первого слоя плиты. Для экономии времени вычислений и учета малой релаксации нижних слоев сляба расчеты проводились с частичной оптимизацией геометрии - оптимизировались положения атомов только верхних четырех атомных слоев и молекулы адсорбата, а пятый слой был зафиксирован как в объеме кристалла.



Рисунок 2 - Модели поверхности ($10\overline{0}$) ZnO с CO₂ в различных конфигурациях: (a) монодентат-1; (b) монодентат-2; (c) бидентат-1; (d) бидентат-2; (e) тридентат; (f) в вакансии

Для простоты показаны только два верхних слоя плиты. Средние красные шары-это атомы О, а большие серые шары-атомы Zn, средние коричневые шары-атомы С. Для упрощения показаны только верхние 2 слоя поверхности.

Результаты расчетов энергии адсорбции E_{ads} , эффективных ионных зарядов q_{eff} , расстояний и углов а между поверхностью и молекулой, а также расстояния между атомами молекулы и угла изгиба молекулы (O1-O2) представлены в таблице 2.

	монодентат-1	монодентат-2	бидентат-1	бидентат-2	Тридентат
$E_{ads}(\Im B)$	-0.56	-0.31	-0.36	-1.3	-1.64
$q_{eff}(O_1/C/O_2),e$	-0.59/+1.2/-	-0.56/+1.1/-	-0.54/+1.2/-	-0.65/+0.92/-	-0.67/+0.9/-
	0.52	0.56	0.54	0.69	0.66
d(C-O _{surf}), Å	-	2.81	-	1.41	1.38

Таблица 2

$d/(Zn_{surf}-O_1/$	2.26/-	-	2.49/2.49	1.97/2.76	2.05/2.17
Zn _{surf} - O ₂), Å					
α,°	68.49	0	0	-	-
C= O ₂),Å	1.16/1.17	1.16/1.16	1.16/1.16	1.22/1.27	1.26/1.25
∠ (O ₁ -O ₂), °	177	171	-	130	130

На рис. З показаны PDOS для всех рассмотренных конфигураций CO₂. Адсорбция приводитк образованию уровней молекулярной энергии в пределах запрещенной зоны ZnO. Первые три слаба связанные молекулярные конфигурации создают уровни в области от -5 до -6 эВ, вызванные орбиталями CO₂ 2p, сопровождающиеся уменьшением химической связи ближайших атомов Zn и O. В отличие от этого другие конфигурации показывают перекрытие орбиталей CO₂ 2p и O_{surf} 2p в широком диапазоне энергий (от -1 до -8 эB). Это указывает на сильную ионную связь. В отличие от бидентатной структуры (d), тридентатная структура (e) демонстрирует значительное взаимодействие (энергетические уровни около -6 эВ) между орбиталями Zn_{surf} 4s и CO₂ 2p из-за химической связи поверхностных атомов Zn и атомов O в молекуле.



Energy, eV

Рисунок 3 - Плотность электронных состояний (Projected density of states-PDOS) для молекулыСО₂ в различных конфигурациях (рис. 2). Уровень Ферми (Е_F) обозначен вертикальной пунктирной линией при 0 эВ

Согласно нашим результатам по энергии адсорбции (Таблица 2), наиболее выгодной конфигурацией адсорбции CO_2 является тридентатная конфигурация, но с учетом отрицательных значений энергий адсорбции других конфигураций мы не исключаем существование возможных менее устойчивых состояний. На основании полученных результатов и следования адсорбции CO2 на других оксидных поверхностях делается вывод о том, что тридентатная структура начинает проявляться и накапливаться при высоких температурах в виде карбонатов. Увеличение покрытия молекулы не изменяет энергию адсорбции, а поверхностные вакансии только уменьшают ее. Возможным

объяснением наблюдаемых результатов по адсорбции CO2 может быть образование на поверхности нового химического продукта H2CO в результате взаимодействия CO2, например, с адсорбированным H2.

Список использованных источников

1. Cho P.S., Kim K.W., Lee J.H. NO₂ sensing characteristics of ZnO nanorods prepared by hydrothermal method // J. Electroceramics. $-2006. - T. 17. - N \ge 2. - C. 975-978.$ doi: 10.1007/S10832-006-8146-7.

2. Devi G.S., Subrahmanyam V.B., Gadkari S.C., Gupta S.K. NH_3 gas sensing properties of nanocrystalline ZnO based thick films // Anal. Chim. Acta. – 2006. – T. 568. - N_2 1–2. - C. 41-46. doi: 10.1016/J.ACA.2006.02.040.

3. Gong H., Hu J.Q., Wang J.H., Ong C.H., Zhu F.R. Nano-crystalline Cu-doped ZnO thin film gas sensor for CO // Sensors Actuators B Chem. $-2006. - T.115. - N \ge 1. - C. 247-251.doi: 10.1016/J.SNB.2005.09.008.$

4. Monkhorst H.J., Pack J.D. Special points for Brillouin-zone integrations // Phys. Rev. B. – 1976. – T. 13. - № 12. - P. 5188. doi: 10.1103/PhysRevB.13.5188.

5. Oba F., Togo A., Tanaka I., Paier J., Kresse G. Defect energetics in ZnO: A hybrid Hartree-Fock density functional study // Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys. – 2008. – T. 77. - № 24. -P. 245202. doi: 1103/PHYSREVB.77.245202/FIGURES/3/MEDIUM.

6. Janotti A., Van De Walle C.G. Native point defects in ZnO // Phys. Rev. B - Condens. MatterMater. Phys. – 2007. – T. 76. - № 16. – P. 165202.

doi:10.1103/PHYSREVB.76.165202/FIGURES/13/MEDIUM.

7. Karzel H., Potzel W., Köfferlein M., Schiessl W., Steiner M., Hiller U., Kalvius G., MitchellD., Das, T. Lattice dynamics and hyperfine interactions in ZnO and ZnSe at high external pressures // Phys. Rev. B. – 1996. – T. 53. – № 17. – P. 11425. doi: 10.1103/PhysRevB.53.11425.

8. Karzel H., Potzel W., Köfferlein M., Schiessl W., Steiner M., Hiller U., Kalvius G., MitchellD., Das, T. Lattice dynamics and hyperfine interactions in ZnO and ZnSe at high external pressures // Phys. Rev. B. – 1996. – T. 53. - № 17. - P. 11425. doi: 10.1103/PhysRevB.53.11425.

ӘОЖ 544.64:544.032.4 Pd/Ag/ПЭТФ ҚҰРАМДЫ БИКОМПОНЕНТТІ КОМПОЗИТТІ ТРЕКТІ МЕМБРАНАЛАРДЫ АЛУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ОРГАНИКАЛЫҚ БОЯҒЫШТАРДЫҢ ФОТОКАЛИТИКАЛЫҚ ЫДЫРАУ РЕАКЦИЯСЫНДА ҚОЛДАНУ

Рахымов Өркен Манарбекұлы

<u>orken_97.zaisan@mail.ru</u> Физика-техникалық факультетінің 2-курс магистранты Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр -Сұлтан, Қазақстан Ғылыми жетекшісі – Машенцева А.А.

Органикалық және бейорганикалық ластағыш заттардан әртүрлі шығу тегі бар суды тазартудың қолданыстағы әдістерінің сан алуандығы бар технологияларды іздеу және жетілдіру қажеттілігін алға тартады [1]. Атап айтқанда, фотохимиялық тотығу технологиялары ең үлкен артықшылықты көрсетеді, өйткені олар табиғи күн энергиясын пайдалануғамүмкіндік береді. Технологияның ерекшелігі нанофотокатализдің жаңартылатын энергиясын пайдалану нәтижесінде деструктивті процестерді жүзеге асыруда [2]. Улы химикаттар су жүйесіне адамның әртүрлі әрекеттері арқылы енеді. Органикалық ластағыш заттардың жалпы түрлеріне эндокриндік бұзылулар, пестицидтер, органикалық бояғыштар,